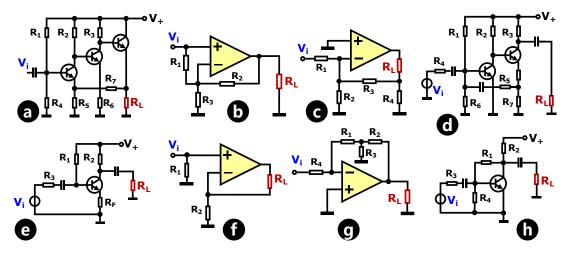
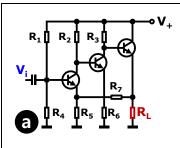
20-1 对于下面各个反馈电路:

- ① 请分析反馈组态 (以R_L为负载);
- ② 若深度负反馈成立, 计算 A_{VF} 或 A_{rF}, R_{iF}, R_{oF}



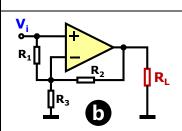
参考:



- a) 反馈组态: 电压串联
- 深度负反馈 \rightarrow $V_{bel} \approx 0$ \rightarrow $V_{R5} \approx V_i$ 以及 $V_{iel} \approx 0$

$$ightharpoonup V_{RL} rac{R_5}{R_5 + R_7} \cong V_{R5} \cong V_i \qquad
ightharpoonup A_{VF} pprox rac{R_5 + R_7}{R_5}$$

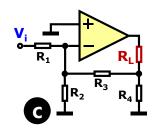
- BJT1 基极输入电流为 $0 \rightarrow R_{iF} \approx R_1//R_4$
- 因输出电压增益与 R_L 无关 → $R_{oF} \approx 0$



- b) 反馈组态: 经 R2 引入电压串联负反馈
- 单看 R₁ 的深度负反馈,则:

$$A_{VF} pprox rac{R_1 + R_2}{R_1}$$
; $R_{iF} pprox \infty$; $R_{oF} pprox 0$

● 【R₁是挖坑的干扰项。它引入了正反馈(电压并联),但它远弱于深度负反馈的部分,不会产生显著作用——因为虚短,R₁两端无显著压降,故电流近似为零——类似于自举电路中输入端电阻的情况,以及电荷放大器中分布电容不能充电的情况】



c) 反馈组态: 电流并联

【由于虚地,R₂上并无电流】

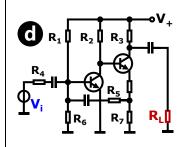
$$V_{R4} = -I_{R1} R_3 = -\frac{R_3}{R_1} V_i$$

→ 由下向上的
$$I_{R_4} = \frac{0 - V_{R_4}}{R_4} = \frac{R_3}{R_4 R_1} V_i$$

$$\rightarrow$$
 由下向上的 $I_{R_L} = I_{R3} + I_{R4} = \frac{1}{R_1} V_{\rm i} \left(1 + \frac{R_3}{R_4} \right)$

•
$$A_{VF} = -\frac{R_L}{R_1} \left(1 + \frac{R_3}{R_4} \right)$$
 参考极性上正下负

- $R_{iF} \approx R_1$ $\leftarrow R_1$ 右端为虚地
- ▶ $R_{0F} \approx \infty$ ← 输出电流与 R_L 无关的理想电流源



d) R5 引入的反馈组态: 电流并联

- 深度负反馈条件下,前级 BJT 基极电流约为 0;
 - → 考虑到其 rbe 有限, 因此其基极动态电压约为 0
 - \rightarrow 流经 R4 的电流约为: $I_i = I_{R4} = \frac{v_i}{R_A}$

$$\rightarrow I_{R_5} = I_i \rightarrow V_{R_7} = -I_{R_5} R_5 = -\frac{R_5}{R_4} V_i$$

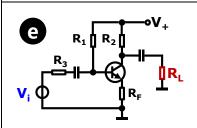
→ 从下向上的
$$I_{R_7} = \frac{0 - V_6}{R_6} = \frac{R_5}{R_7 R_4} V_i$$

→ 后级 BJT:
$$I_c \approx I_e = -I_{R_5} - I_{R_7}$$

= $-\frac{1}{R_s}V_{\rm i}\left(1 + \frac{R_5}{R_7}\right)$

$$\rightarrow V_{R_L} = -I_c(R_3//R_L) \rightarrow A_F = \frac{R_3//R_L}{R_4} \left(1 + \frac{R_5}{R_7}\right)$$

- $R_{iF} \approx R_4$ ← 深度负反馈使 BJT1 基极近似动态地
- $R_{oF} \approx R_3$ ← 深度负反馈使 BJT2 集电极向内电阻更趋于无穷大



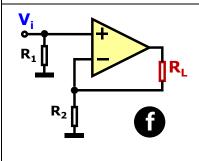
e) R_F引入的反馈组态:电流串联

- 深度负反馈 → 动态信号 V_{BE}≈0 → I_B≈0
 - ightharpoonup 基极动态电压为 $V_B \approx \frac{R_1}{R_3 + R_1} V_i \approx V_{R_F}$

$$ightharpoonup I_{R_F} pprox rac{R_1}{R_F(R_3 + R_1)} V_i = I_{\rm E} pprox I_{\rm C}
ightharpoonup$$

$$A_F = -\frac{R_1(R_2//R_L)}{R_F(R_3+R_1)}$$

- $R_{iF} \approx R_3 + R_1$ ← 深度负反馈使 BJT 基极电流约 为零(组态为串联负反馈,其实是使得晶体管基极 向内电阻近似为无穷大)
- $R_{oF} \approx R_2$ ← 深度负反馈使 BJT 集电极向内电阻 更趋于无穷大

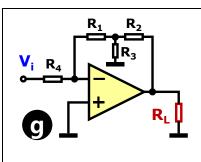


f) R.引入的反馈组态: 电流串联

•
$$\&$$
 $\&$ $\&$ $V_{R_2} \approx V_i \rightarrow I_{R_F} \approx I_{R_2} = \frac{1}{R_2} V_i$

→
$$A_{VF} \approx \frac{R_L}{R_2}$$
 (参考极性上正下负)

- $R_{oF} \approx \infty$ \leftarrow 深度负反馈使 R_L 获得与阻值无关的 电流,趋于理想电流源

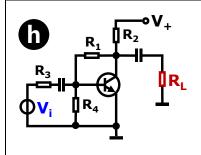


- g) 反馈组态: 电压并联

$$\rightarrow V_{RL} \approx V_{R3} + V_{R2} = -\frac{R_1}{R_4} V_{i} - \frac{R_2}{R_4} \left(1 + \frac{R_1}{R_3}\right) V_{i}$$

$$\rightarrow A_{VF} = -\frac{R_1}{R_4} - \frac{R_2}{R_4} \left(1 + \frac{R_1}{R_3}\right)$$

- $R_{iF} \approx R_4$ ← 反相输入端近似动态地
- $R_{oF} \approx 0$ ← A_{VF} 与 R_L 无关,近似理想电压源



- h) 反馈组态: 电压并联
- 深度负反馈条件下,动态信号: I_B≈0
 - → r_{be}有限,故 V_{be}≈0 (基极近似动态地)
 - → R₄ 两端几乎没有动态电压差,也没有动态电流

→
$$I_{R3} \approx \frac{1}{R_2} V_i \approx I_{R1}$$
 (从左向右)

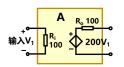
→
$$V_{\rm RL} = -I_{R1} R_1 = -\frac{R_1}{R_2} V_{\rm i}$$
 → $A_{\rm VF} \approx -\frac{R_1}{R_2}$

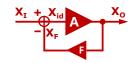
【注:单级电路中,根据深度负反馈的题设直接得到 $I_B \approx 0$ 之后,到底有哪些变量可以推演中近似为零(V_{be} 、 I_C 之类),其实并不是那么严谨的——这种尴尬主要是因为注 1 里所说的"相对勉强的题设"所带来的。多级电路的级间反馈,相对就不必这么"勉强"】

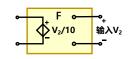
21.1 反馈电路计算

某放大器的中频增益会随环境变化而呈现 ±5% 的误差 (即: A的变化范围是 [190, 210])。请问:

- a) 若如右图般引入 F=-1/5 的正反馈,则闭 环增益 A_F 的变化范围是?
- b) 若如右上图般引入 F=1/5 的负反馈,则闭环增益 A_F 的变化范围是?
- c) 请画出二者构成 电压串联负反馈放大器后的总图。并计算闭环后,反馈放大器的 A_F 、 R_{iF} 和 R_{oF} 各是多少?
- d) 在 c) 的基础上,如果原放大器是一阶低通 的(f_H = 1kHz),则反馈闭环后,放大 器的截止频率是多少?







参考:

a) 当开环增益 A 约为 200 时,如果正反馈 F=-1/5,显然此时 1+AF<0,这属于发散的正反馈。

因此,这种情况下,闭环电路"并~不~是~放~大~器~" 于是题目里要计算的 A_F 其实是没有意义的。

【这部分是作业里挖的一个小坑】

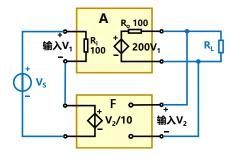
- b) 把 F=1/5,以及 A_{min} =190 和 A_{max} =210 分别代入反馈基本方程: $A_F = \frac{A}{1+AF} = \frac{1}{A^{-1}+F}$ 则可以得到 $A_{F, min}$ \approx 4.87 和 $A_{F, max}$ = 4.88,考虑到反馈基本方程是 A 的严格单调递增函数,故 A_F 的范围为: [4.87, 4.88]
- c) 【原本设计题目时,想说明的是将右侧上图和下图 (F=1/10)来合成电压串联负反馈放大器。但题目 文字中说得有些含混,导致有的同学使用了 F=1/5 来计算。很抱歉】

对于这个上面的情况,合成电路如右图: 由于是理想反馈,故:

$$A_F = \frac{A}{1 + AF} \quad \Rightarrow \quad A_F \in [9.50, 9.54]$$

$$R_{iF} = (1 + AF)R_i \quad \Rightarrow \quad R_{iF} \in [2.0k\Omega, 2.2k\Omega]$$

$$R_{oF} = \frac{R_o}{1 + AF} \quad \Rightarrow \quad R_{oF} \in [4.55\Omega, 5\Omega]$$



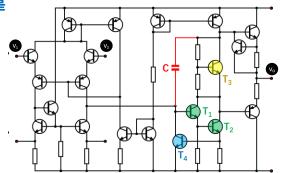
d) 根据 $f_{HF} = (1 + AF)f_H$ → $f_{HF} \in [20kHz, 22kHz]$

21.2 频率补偿

BJT构成的运放如下图所示。其中所有BJT的 CB'E = CB'C = 10pF

在引入 C= 1uF 进行主极点补偿 之前,整个电路的开环增益是 10⁴ ,而 f_H =1MHz。

- a) 请问加入 C 之后, 运放的 f_H 变为多少呢?
- b) 利用补偿 C 后的运放, 实现一个A_总=10 的同相放 大器,请画出电路图。
- c) 对于 b 中的电路, 请计 算该电路的 R_i, R_o, f_H?



参考:

【首先需要说明,在C附近的几个BJT中:

- T1、T2 构成达林顿电路,配合上方的镜像电流源,构成电路的高增益放大级:
- T3 是后级推挽电路的 V_{BE} 增强电路,用于消除交越失真的;
- T4 是保护电路, 当其基极下侧的小电阻没有大直流通过时, T4 不会导通。】
- a) 按题设,引入 C 来做主极点补偿,这意味着在"带宽增益积基本恒定"的条件下,T1 和 T2 构成的高增益放大级,是形成放大器主极点的位置。其中,T1 的 C_{B'C} 受密勒效应最为显著,是制约瓶颈的主要因素。

在补偿前 $f_H=1MHz$,而因为 C 与 $C_{B'C}$ 接近于并联(其实此处忽略了 r_b 的影响,以及 T3 的 V_{BE} 增强电路各节点之间的小电阻),所以形成主极点的电容从 10pF 变为 1uF,增加了 5 个数量级 \rightarrow 按时间常数估算,这将导致 f_H 下降五个数量级 \rightarrow 补偿后 f_H 降为 10Hz 左右。

【需要说明,其实在复合管中,第二级(图中 T2)的 $C_{B'C}$ 其实也不能完全忽略,有不小的影响。但具体分析起来,将使这道题变得很繁琐。这是出题不慎之处,请原谅】

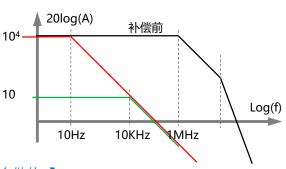
- b) 标出两个输入端为 V_1 和 V_2 ,则不难判断: V_1 为同相输入端, V_2 为反相输入端。 由此,题目需要的同相放大器的结构如右图: 为实现增益为 10,只需取 $R_2 = 9R_1$ 即可。 【当然,设计题,并没有唯一的标准答案】
- R_1

c) 对于 b)中构造的电压串联反馈,

A_{VF} = A/(1+AF), 代入 A=10⁴ 和 A_{VF} ≈ 10 → D = 1+AF ≈ 10³

→ 闭环后 $f_{HF} = f_H \cdot D = 10$ Hz $\cdot 10^3 \approx 10$ KHz 另外, $R_{iF} \approx \infty$, $R_{oF} \approx 0$,这个易于看出。

【注:题设中开环增益 10⁴,而补偿电容使得 f_H 下降五个数量级,补得太过头了——这样几乎必然 使得第二极点远远低于横轴,真实电路中是不会这么做的。】

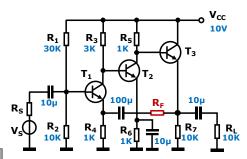


22.3 电路仿真

在电路仿真软件 (JLCEDA) 中构造右图所示的电路。

- a) 确认各BJT (均为2N2222) 工作于放大状态;
- b) 请通过仿真测量,使用不同 R_F 时,电路的性能指标, 埴入下表:

R _F	A _F	R _i	R _o	f _H
∞				
100K				
10K				
1K				



并尝试与理论值相比较。

参考:【此题目中未给出 R_S 的数值,这是不妥的。下面按 $R_S = 0$ 来仿真。如果采用了别的 R_S ,结果会有所不同—— A_F 偏小一些、 f_H 偏小一些】。注意事项:

- 仿真时可以使用交流分析(注意设置源的 AC 幅度为 1, AC 相位为 0);
- 仿真点数可以取得多一些
- 仿真得到的 A_F 增益是 dB, 需要用 10[^](A_F/20) 转换为倍数;
- 测量 R_i 时,可以分别测量 $R_S = 0$ 和不等于零(譬如 $2k\Omega$)的两个 A_F 值(记为 A_{F1} 和 A_{F2}),则可以根据 $A_{F2} = A_{F1} R_i / (R_S + R_i)$,即:求解出 R_i
- 测量 R_o 时,可以分别测量 R_L 两个有限值(譬如 $10k\Omega$ 和 50Ω)的两个 A_F 值(记为 A_{F1} 和 A_{F3}),则可以根据 $A_{F3} \approx A_{F1} \cdot R_L/(R_O + R_L)$ 求解出 R_o
- a) 仿真时,通过测量各 BJT 的三端电压,可以确认各 BJT 都处于放大状态。
- b) 测量结果如下:

R_{F}	A _{F1} (dB)	A_{F1}	A _{F2} (dB)	A_{F2}	$R_i(\Omega)$	A _{F3} (dB)	A_{F3}	$R_o(\Omega)$	$f_{H}\left(\mathrm{Hz}\right)$
∞	42.1	127	40.0	100	7.41 k	35.9	62.4	51.8	186 k
100K	35.04	56.5	32.95	44.4	7.34 k	31.77	38.8	22.8	421 k
10K	20.17	10.2	18.10	8.04	7.44 k	19.53	9.47	3.85	2.62 M
1K	5.95	1.98	3.89	1.56	7.43 k	5.88	1.97	0.25	44.4 M

其中,绿色格子为最后所需要的结果(颜色较深的九个格子,将在下面做对比使用)。

对于后三行而言,可以有:

- 用 A_F=A/D 来估算反馈深度 D
- 由于到受反馈影响的 R_i 是 T1 的基极向内电阻,根据上表第一行可估算该电阻约为: $R_{i2} \approx 617 k\Omega$,则在电压串联负反馈的条件下有: $R_{i2F} \approx R_{i2} \cdot D$, $R_{oF} \approx R_o / D$
- $f_{HF} \approx f_H \cdot D$

R_{F}	A_{F1}	D	$R_{i2F}(\Omega)$	$R_{iF}\left(\Omega\right)$	$R_{oF}(\Omega)$	f _{HF} (Hz)
100K	56.5	2.25	1.39M	7.46	23	418 k
10K	10.2	12.45	7.68M	7.49	4.16	2.32 M
1K	1.98	64.14	39.6M	7.50	0.81	11.93 M

蓝底色的格子中的数据跟前表中的数据基本可以比拟,除了最后一项(44.4M vs 11.93M)。说明使用反馈深度是可以进行一些粗估计算的。

25-1 有源滤波器

•请推导下面各电路的频率响应: V。/ Vi

a) 在 A 节点列写 KCL (注意运放反相输入端为虚地): $(V_i-V_A)/R_1 = V_A/Z_2 + (V_A-V_o)/R_4 + V_A/R_3$ $V_A/R_3 = -V_o/Z_5$

其中: $Z_2=1/j\omega C_2$ $Z_5=1/j\omega C_5$

$$\begin{split} H(\omega) &= \frac{V_o}{V_i} = -\frac{Z_2 R_4 Z_5}{R_1 R_3 R_4 + (R_1 R_3 + R_3 R_4 + R_1 R_4) Z_2 + R_1 Z_2 Z_5} \\ &= -\frac{R_4}{-\omega^2 R_1 R_3 R_4 C_2 C_5 + j\omega (R_1 R_3 + R_3 R_4 + R_1 R_4) C_5 + R_1} \end{split}$$

显然, 当 $\omega \rightarrow 0$ 时, 趋于常数 $-R_4/R_1$, 构成反相放大器 $(R_3$ 就像不存在一样);

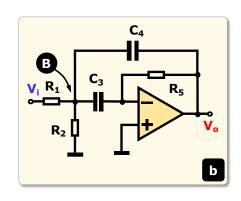
当 ω → ∞ 时,是两阶无穷小。

综上,构成二阶低通滤波器。

b) 计算方法和前面 a 中一样, 因此做简单替换后即可得到结论:

$$H(\omega) = \frac{V_o}{V_i} = -\frac{R_2 Z_4 R_5}{R_1 Z_3 Z_4 + (R_1 Z_3 + Z_3 Z_4 + R_1 Z_4) R_2 + R_1 R_2 R_5}$$

$$= -\frac{j \omega C_3 R_2 R_5}{-\omega^2 R_1 R_2 R_5 C_3 C_4 + j \omega (C_3 + C_4) R_1 R_2 + R_1 + R_2}$$
 显然,当 $\omega \to 0$ 和 $\omega \to \infty$ 时,上面式子均趋于 0,因此实际构成了一个带通滤波器

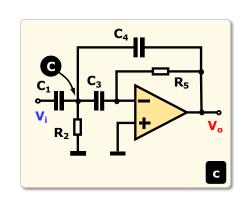


а

c) 方法和前面 a 中一样, 只是得到的结论是:

$$H(\omega) = \frac{V_o}{V_i} = -\frac{R_2 Z_4 R_5}{Z_1 Z_3 Z_4 + (Z_1 Z_3 + Z_3 Z_4 + Z_1 Z_4) R_2 + Z_1 R_2 R_5}$$

$$=\frac{\omega^2 C_1 C_3 R_2 R_5}{-\omega^2 R_2 R_5 C_3 C_4 + j \omega (C_1 + C_3 + C_4) R_2 + 1}$$
显然,当 $\omega \to 0$ 时,该式子是两阶无穷小
当 $\omega \to \infty$ 时,上面式子趋于 $-C_1/C_4$ (具有固定增益)
因此该电路实际构成了一个高通滤波器



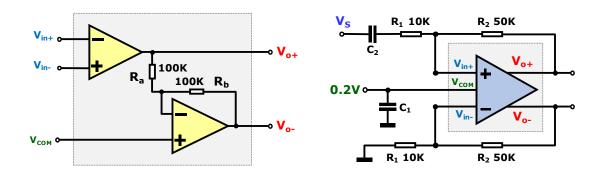
【有的同学直接使用五个 Z 器件来进行计算,最后再在某些元件代入电容,这样确实更方便易行。】

25-2 全差分放大器

全差分放大电器,是指输入和输出都采用双线的差模传输的放大器。其一种简化电路可以用下面左图来 等效。当其加上(对称的)反馈后,构成下面右图。

试计算,当输入信号为单端信号 $V_S = 3 + 0.1 \sin \omega t$ 时,电路的输出 V_{o+} 和 V_{o-} 。

假设电容为足够大。提示: 分为直流和交流两部分计算。



参考: 此电路所有运放都工作于线性区, 因此单路可以采用叠加原理进行分析。

• 先计算直流部分:

 $I_{R2} = I_{R1} = 0$ **>** $V_{o+} = V_{in+} = V_{in-}$ $R_a = R_b$,且二者相连处节点电压 $\approx V_{COM} = 0.2$ **→** $(V_{o+} + V_{o-})/2 = V_{COM} = 0.2$ 此外,按最下侧电路的分压: $V_{o-} \bullet R_1/(R_1 + R_2) \approx V_{in-}$ 将上面这几个式子联立求解,可得: $V_{o+} = 2/35$; $V_{o-} = 12/35$

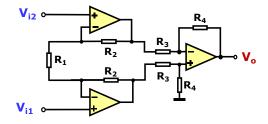
• 计算交流部分:

综上, $V_{o+} = -0.25 \sin(\omega t) + 2/35$; $V_{o-} = 0.25 \sin(\omega t) + 12/35$

【注意,有的同学不区分交直流而直接把 V_s 代入电路求解,会得到不一样的结果。这是因为电容 C_2 上的电压其实并不是正好3V——按上面的计算可以知道, V_{C2} =3-2/35V】

25-3 仪表放大器

- •运放输出可写为: $V_o = A_{VC}V_{ic} + A_{VD}V_{id}$
 - 其中: A_{VD} = 10⁵, A_{VC} = 1。
- ·请算出下面电路的 V。是多少? 已知:
 - $R_1=200\Omega$; $R_2=10K$; $R_3=20\Omega$; $R_4=10K$
 - $V_{i1} = 4V + \sin(\omega t) \, mV$; $V_{i2} = 4V \sin(\omega t) \, mV$



参考:

【对于此题,有的同学在分析过程中,直接忽略了共模部分。因为共模输出量确实很小, 所以答案也还是在前面声明过得"±5%"的范围内,这是出题的时候没考虑到的。 另外,在计算的过程中,因为不同的取舍方式,也常常有不同的微小差异】

由于电路全部工作在线性区,因此可以采用叠加原理进行分析: 共模部分和差模部分。其中,

● 对于前一级的两个运放而言:

差模部分: $V_{i1d} = \sin(\omega t)$; $V_{i2d} = -\sin(\omega t)$ mV,

此时 R₁ 的中点相当于动态地, 因此可以很容易计算得到:

 $V_{o1d} = \sin(\omega t) \cdot (1 + 2R_2/R_1) \text{ mV}; \quad V_{o2d} = -\sin(\omega t) \cdot (1 + 2R_2/R_1) \text{ mV}$

共模部分: 利用虚短可知: $V_{i1c} = 4V + \sin(\omega t) \, mV$; $V_{i2c} = 4V - \sin(\omega t) \, mV$

 $V_{o1c} = A_{VC} \cdot [4000 + \sin(\omega t)] \text{ mV}; \quad V_{o2c} = A_{VC} \cdot [4000 - \sin(\omega t)] \text{ mV}$

故:
$$\begin{cases} V_{o1} = 4000 + 102\sin(\omega t) \, mV \\ V_{o2} = 4000 - 102\sin(\omega t) \, mV \end{cases}$$

● 将这一结果代入后一级的运放:

差模部分:这是一个正常的减法电路, $V_{o3d} = (V_{o1} - V_{o2}) \cdot R_4/R_3 = 102 \sin(\omega t) V$

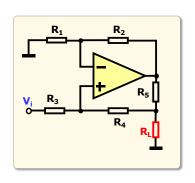
共模部分: $V_{ic3} = \frac{R_4}{R_2 + R_4} V_{o1}$,因此 $V_{oc3} \approx A_{VC} \frac{R_4}{R_2 + R_4} V_{o1} \approx 4 + 0.102 \sin(\omega t) V_{oc3}$

故综合起来,输出结果为: $V_{o3} \approx 4 + 102.102 \sin(\omega t) V$

【当然,这个数值看起来太不正常了,这是出题的时候电阻的量级给错了】

25-4 Howland 电流源

- ・此电路将电压源 V_i 转换为流经 R_l 的电流。
- 请推算:
 - 各电阻间应满足什么条件,才能使得整个电路相对于 R_i 的输出电阻接近 ∞。
 - 注意, R, 需能够获得正比于 V; 的电流。



【思路一(舍弃)】: 凑约束方程

- 假设运放输出电压为 V。→ 运放反相输入端电压V. → 运放同相输入端电压V+
 - → R_3 上的电流 → R_4 上的电流 → R_4 右端 (R_L 上端) 的电压 V_{RL}
 - → 由此同时得到流经 RL 和 流经 R5的电流 → 它们和流经 R4 的电流满足 KCL
 - → 由此可得 V。的表达式 → 代入后计算出 V_{RL} 表达式
 - → 按题意(恒流源输出电阻无穷大),令上述表达式正比于 RL即可得最终约束关系
- 上述过程思路比较直接,但使用符号运算的步骤太长,导致推演时式子比较繁

【思路二】: 凑约束方程

- 假设 R_L上端电压为 V_{RL}→ 运放同相输入端电压V_L→ 运放反相输入端电压V
 - → 运放输出端电压 V_0 → 流经 R_5 的电流 → 它和流经 R_4 、流经 R_L 的电流满足 KCL
 - → 由此可得 V_{RL} 的表达式
 - → 按题意(恒流源输出电阻无穷大),令上述表达式正比于 R₁即可得最终约束关系
- 这个过程其实和思路一相仿,但步骤和繁复程度缩短不少,如下:

$$\bullet \quad V_- \cong V_+ = \frac{R_4}{R_3 + R_4} V_i + \frac{R_3}{R_3 + R_4} V_{RL} \quad \Rightarrow \quad V_o \cong \frac{R_1 + R_2}{R_1} \left(\frac{R_4}{R_3 + R_4} V_i + \frac{R_3}{R_3 + R_4} V_{RL} \right)$$

→ 代入
$$I_{R4}+I_{R5}=I_{RL}$$
 可得: $\frac{V_i-V_{RL}}{R_3+R_4}+\frac{1}{R_5}\Big[\frac{R_1+R_2}{R_1}\Big(\frac{R_4}{R_3+R_4}V_i+\frac{R_3}{R_3+R_4}V_{RL}\Big)-V_{RL}\Big]=\frac{V_{RL}}{R_L}$

→ 移项化简:
$$\left(\frac{1}{R_3+R_4} + \frac{1}{R_5} \frac{R_1+R_2}{R_1} \frac{R_4}{R_3+R_4}\right) V_i = \left(\frac{1}{R_3+R_4} + \frac{1}{R_L} + \frac{1}{R_5} - \frac{1}{R_5} \frac{R_1+R_2}{R_1} \frac{R_3}{R_3+R_4}\right) V_{RL}$$

→ 显然,为使得 $V_{RL} \propto R_L$,需使得右侧括号中除 $\frac{1}{R_L}$ 项之外相互抵消,

即可得:
$$\frac{1}{R_2+R_4} + \frac{1}{R_5} - \frac{1}{R_5} \frac{R_1+R_2}{R_1} \frac{R_3}{R_2+R_4} = 0$$
, 最终化简为: $R_1(R_4+R_5) = R_2R_3$

【思路三】直接按电流源特征,写出电路 R。表达式为无穷大的方程即可

- 计算面向 R_L 的输出电阻时,源 V_i 置零(这一操作省不少麻烦!),把 R_L 改为电压源 V_X ,则令 R_o ≈∞ 相当于:施加 V_X 后,对电路产生的电流 I_X ≈0
- 此时, $V_- \cong V_+ = \frac{R_3}{R_3 + R_4} V_X$ \rightarrow $V_o \cong \frac{R_1 + R_2}{R_1} \frac{R_3}{R_3 + R_4} V_X$

为使得 $I_x \approx 0$,只需 $I_{R4} \approx I_{R5}$,即: $\frac{V_X}{R_3 + R_4} \cong \frac{1}{R_5} \left(\frac{R_1 + R_2}{R_1} \frac{R_3}{R_3 + R_4} V_X - V_X \right)$

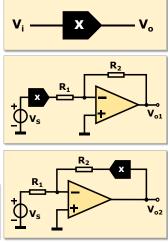
对此式子化简,即可得到: $R_1(R_4 + R_5) = R_2R_3$

27-1 运算电路

若某电路模块,具有图 a 所示的转移特性 $V_o = F(V_i)$,且已知输入电阻为 R_{xi} ,输出电阻为 R_{xo} 。

- A) 若将它构造成 图b 和 图c 的运算电路,请计算电路的输出 V_{o1} 和 V_{o2} 。
- B) 请利用图 d 中的理想四象限乘法电路 $(R_i=\infty, R_o=0)$ 构造一个开方电路。





参考:【抱歉原题图上忘了标 a、b、c、d, 虽然理解起来不会有大问题】 A)图 b:

由于直流负反馈的存在,运放工作在线性区 → 虚短(虚地)成立, V- ≈ 0

- \rightarrow 因为不需要和信号源内阻分压,X 的输入端电压为 $V_i = V_s$,
- → X 的输出端为 $V_0 = F(V_S)$ 的受控电压源,串联 R_{XO} 和 R_1 之后,连接到虚地。
- → 从左至右流经 R_1 的电流为: $F(V_S)/(R_{XO}+R_1)$
- → 这一电流也将流经 R_2 , 产生左正右负的压降: $R_2 \cdot F(V_S)/(R_{XO}+R_1)$
- → 电路输出电压为: V₀₁ = R₂ F(V_S) / (R_{XO}+R₁)

图 c:【此处需要额外假设直流负反馈存在,题目中并未交代】则运放工作在线性区, \rightarrow 虚短(虚地)成立,V- \approx 0

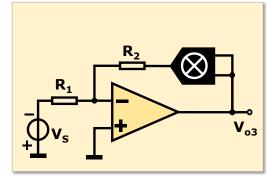
- \rightarrow 从左至右流经 R_1 的电流为: V_S/R_1
- → 因为虚断,这个电流也正是从左向右流过 R₂(流进 X 输出端)的电流
- → 也就是说: F(V_{o2}) / (R_{XO}+R₂) = V_S / R₁
- \rightarrow 【此处需要额外假设函数 $F(\cdot)$ 具有逆函数 $V_{o2} = F^{-1} \left(-\frac{R_{XO} + R_2}{R_1} V_S \right)$

【值得注意的是,模块 X 的接法,是输入端在右,这是因为反馈网络的传输方向是从输出端传导到输入端的。而我们平时采用虚短、虚断和深度负反馈的方法,都是"逆着反馈通道的方向来计算的"】

B) 这是一个设计题,可以有多种不同的可行方案,

其中相对简洁的做法如右图 (注意源的极性): 类似上面图 C 的计算,有:

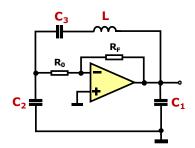
- → 经 R₁和 R₂至 X 输出端的电流为: -V_S/R₁
- → 也就是说: $V_0^2 / R_2 = V_S / R_1$
- → 这就是一个典型的(可调比例的)开方运算



27-2 电容三点式振荡器

已知 $C_1 = 20nF$, $C_2 = 10nF$ $C_3 = 100pF$, L = 10nH。

- a) 若电路能在高Q条件下输出正弦波, 请估算正弦波的频率
- b) 为了能起振,请估算电阻 R_F 和 R₀ 需满足什么条件?
- c) 已知运放是绝对稳定的,则构造此 电路对其主极点 f₁ 有何要求?



参考:

a) 高Q条件,意味着纯 LC 回路为谐振回路,是确定振荡器的选频网络。 由图可知,回路 L-C1-C2-C3 是振荡器的选频网络,其谐振频率为:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC_{E}}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{L\left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_2}\right)^{-1}}} \cong 159 \, MHz$$

b) 高 Q 谐振时, LC 回路中的电流为主要电流(其它支流的电流可以近似忽略),

此时,LC 回路中的反馈电压比 $F = -\frac{V_{C2}}{V_{C1}} = -\frac{C_1}{C_2}$,

而运放与 R_0 和 R_F 构成的放大器的增益为 $A_0 = -\frac{R_F}{R_0}$

因此,为了能够起振,需要: $A_0F > 1$,即: $\frac{R_F}{R_0} \frac{C_1}{C_2} > 1$

【值得注意的是,这里三点式 LC 回路引入的反馈组态乍一看像是电压并联型(因为反馈到了 R_0 的左端)。但这里其实是既可以看成电压并联型反馈,也可以看成电压串联型反馈的,因为信号发生电路中并没有真正的信号源

—— 如果假设 (实质为零的) 信号源是连接在 R_0 左端和地线之间,则上述反馈为电压 并联型:

—— 如果假设(实质为零的)信号源是连接在 R_0 左端和 C_2 上端之间,或直接假设信号源接在运放同相端的,则上述反馈为电压串联型。】

c) 【此处需要额外假设已知运放的开环增益是某个数值 A_{VD} ,题目中并未交代】 在三点式 LC 振荡电路中,高 Q 回路提供选频特性,而放大器承担宽带放大作用。 为了完全由 LC 回路确定振荡频率,放大器(运放与 R_0 和 R_F 构成的放大器)在振荡频率处不应该提供任何相移。

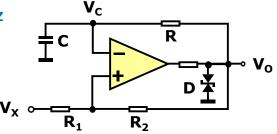
而引入 F 约为 $R_0/(R_0+R_F)$ 的电压反馈(譬如假想信号源接在同相输入端)时,放大器的带宽从 f_H 增为 $f_{FH} \approx f_H \cdot D = f_H \cdot (1+AF) = f_H \cdot [1+A_{VD}R_0/(R_0+R_F)]$;

按上述推断, 需要 $f_{FH} \approx f_H \cdot [1 + A_{VD}R_0/(R_0 + R_F)] >> f_0$

【电路工程中,一般超过10倍可以大致认为是"远大于"】

27-3 方波发生电路的周期

双向稳压器 D 的击穿电压为 $\pm V_Z$ 此电路还有一个输入电压端 V_X 。 请推导完成该电路输出波形 的周期 T 与 V_X 之间的关系。



参考:

这个电路与课上讲解的方波发生器的唯一不同,是引入了 V_X 输入端,这将影响滞回比较器的两个判决门限。

由于在D击穿之后,V。端的电压只能是±Vz,

所以在运放的同相输入端,电压只有两种情形,即: $V_{th1,2} = \frac{R_2V_X\pm R_1V_0}{R_1+R_2}$

由此:

• 在 C 正向充电时,初值是 $\frac{R_2V_X-R_1V_Z}{R_1+R_2}$,末值是 V_Z ,跳变条件是达到 $\frac{R_2V_X+R_1V_Z}{R_1+R_2}$

故所需时间是:
$$T_1 = RC \cdot ln \frac{V_Z - \frac{R_2 V_X - R_1 V_Z}{R_1 + R_2}}{V_Z - \frac{R_2 V_X + R_1 V_Z}{R_1 + R_2}} = RC \cdot ln \frac{(2R_1 + R_2)V_Z - R_2 V_X}{R_2 V_Z - R_2 V_X}$$

● 同理,在 C 反向充电时,初值是 $\frac{R_2V_X+R_1V_Z}{R_1+R_2}$,末值是 -V_Z,跳变条件是达到 $\frac{R_2V_X-R_1V_Z}{R_1+R_2}$

故所需时间是:
$$T_2 = RC \cdot ln \frac{-V_Z - \frac{R_2V_X + R_1V_Z}{R_1 + R_2}}{-V_Z - \frac{R_2V_X - R_1V_Z}{R_1 + R_2}} = RC \cdot ln \frac{(2R_1 + R_2)V_Z + R_2V_X}{R_2V_Z + R_2V_X}$$

● 综上,总周期是

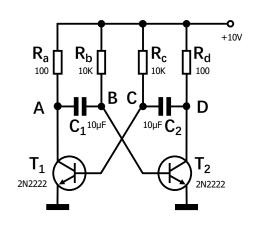
$$T = T_1 + T_2 = RC \cdot ln \frac{(2R_1 + R_2)V_Z - R_2V_X}{R_2V_Z - R_2V_X} + RC \cdot ln \frac{(2R_1 + R_2)V_Z + R_2V_X}{R_2V_Z + R_2V_X}$$
$$= RC \cdot \{ln[(2R_1 + R_2)^2V_Z^2 - R_2^2V_X^2] - lnR_2^2 - ln(V_Z^2 - V_X^2)\}$$

【简单验证:令 Vx=0,则上式退化为讲义中的结果】

27-4 BJT 多谐振荡器

请使用仿真软件,对右图进行仿真。

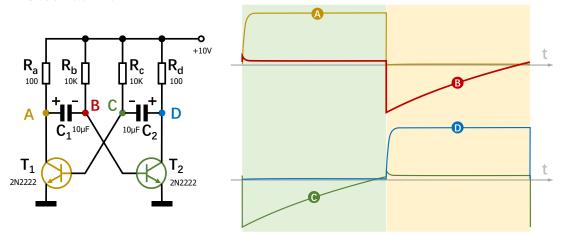
- 1) 绘制一个周期内四个节点: A、
- B、C、D 的波形示意图
- 2) 简要阐述电路的工作过程



参考:

【!!! 直接去尝试理解一个未曾见过的比较复杂的电路(非线性、含动态元件,相互反馈), 其实是很不容易的事情。考试时不可能会让大家直接去面对这样的电路】

1)波形如下面右图:



- 2) 参考上面波形图, 电路的工作过程大致如下:
 - 两个电容交替充电和放电,两个晶体管也分别工作在截止区和饱和区;
 - 在前半周期(上面波形图中绿色背景部分):
 - 1) T2 晶体管饱和导通,因为其基极(节点B)电压超过0.7V,集电极(节点D)电压极小(比较接近于零);
 - 2) 此时电容 C1 基本不充放电 (看图中黄线和红线差距基本不变);
 - 3) 电容 C2 正在稳步放电(图中蓝线和绿线之间的差异越来越小),放电回路是: 电源 \rightarrow R_C \rightarrow C2 \rightarrow 饱和的 T2 的 V_{CE} \rightarrow 地线。
 - 4) 随着充电, C 节点电压越来越高, 直至使 T1 基极导通;
 - 5) 在 T1 变得导通瞬间,两个 BJT 均可以工作在放大状态 → 形成正反馈
 - 6) 正反馈导致电路状态一下子发生翻转: T2 截止, T1 饱和导通;
 - 7) 在 T2 截止前,会对 C1 快速充电 (注意 Ra << Rb), 充电回路是:电源→ R_a → C1 → 饱和的 T1 的发射结 →地线。
 - 8) 另外半周期如法炮制。